

英飞凌超低功耗数字 PDM XENSIV™ MEMS 麦克风

特性

- 高性能模式下的超低电流消耗 (520µA)
- 低功耗模式下的低电流消耗 (180µA)
- 信噪比 (SNR) 为 69dB(A)
- 声过载点 (AOP) 为 128dB SPL
- 平坦的频率响应, 低频截止频率 (LFRO) 为 30Hz
- 器件级 IP57 防水防尘
- 封装尺寸: 3.5mm x 2.65mm x 0.98mm
- 增强的 RF 防护
- PDM 数字输出
- 底部声孔



潜在应用

- 主动降噪 (ANC) 头戴式和入耳式耳机
- 智能手机和移动设备
- 高品质音频采集
 - 笔记本电脑和平板电脑
 - 会议系统
 - 相机和摄像机
- 具有语音用户界面 (VUI) 的设备
 - 智能扬声器
 - 家庭自动化
 - 物联网设备
- 具有音频检测功能的工业或家庭监控



产品验证

符合工业应用的技术。

通过 IEC 60747 和 60749 或 JEDEC47/20/22 的相关测试, 符合工业应用的验证标准。

描述

IM69D128S 是一款超低功耗的 XENSIV™ 数字 MEMS 麦克风, 为在小封装里要求高信噪比 (低自噪声)、长电池寿命和环境稳健性的应用而设计。

69dB(A) 提供的优异信噪比 (SNR), 可实现清晰的音频体验, 同时不影响电池寿命。

通过使用革命性的数字麦克风 ASIC, IM69D128S 设立了新的电流消耗基准, 低至 520µA, 几乎是市面上同类产品的一半。

此外, IM69D128S 掌握了在不同功率和性能配置之间切换的技巧, 且不会产生杂音。

基于英飞凌的密封双膜 MEMS 技术, IM69D128S 可在麦克风级别提供高等级的防护 (IP57)。

Type	Package	Marking
IM69D128SV01	PG-TLGA-5-2	I69D18

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见, 英飞凌提供了译文; 由于翻译过程中可能使用了自动化工具, 英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性, 请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本 (控制文档)。

目录

	特征	1
	潜在应用	1
	产品验证	1
	说明	1
	目录	2
1	框图	3
2	典型性能特性	4
3	声学特性	6
4	电气特性和参数	7
4.1	绝对最大额定值	7
4.2	电气参数	7
4.3	电气特性	8
4.4	音频DC偏置	9
4.5	立体声 PDM配置	10
5	封装信息	11
6	焊盘和钢网模版推荐	12
7	包装信息	13
8	回流焊 和 电路板组装	14
9	可靠性规格	16
9.1	环境稳健性	17
	修订记录	18
	免责声明	19

1 框图

1 框图

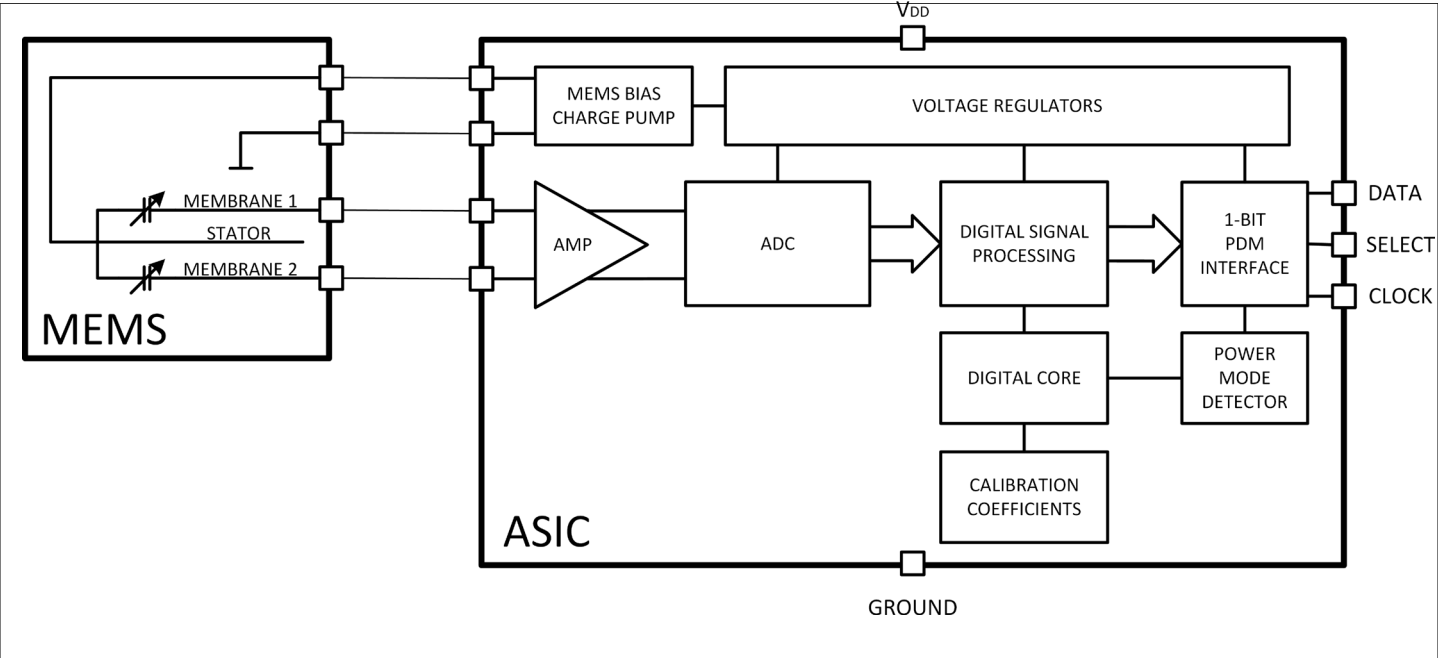


Figure 1 Block diagram

2 典型性能特性

测试条件: $V_{DD} = 1.8V$ 、 $f_{CLK} = 3.072MHz$ 、 $T_A = 25^{\circ}C$ ，除非另有说明。

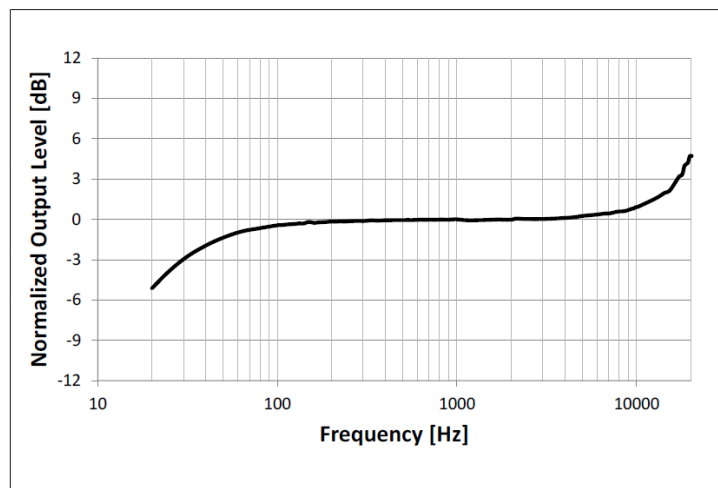


Figure 2 Typical amplitude response

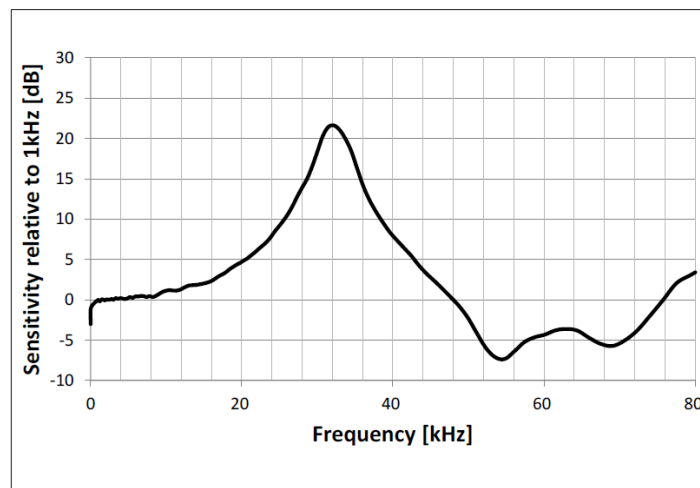


Figure 3 Typical ultrasonic response

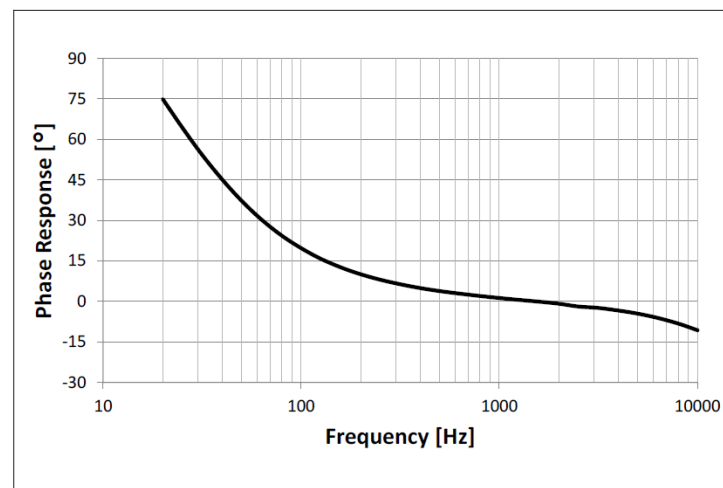


Figure 4 Typical phase response

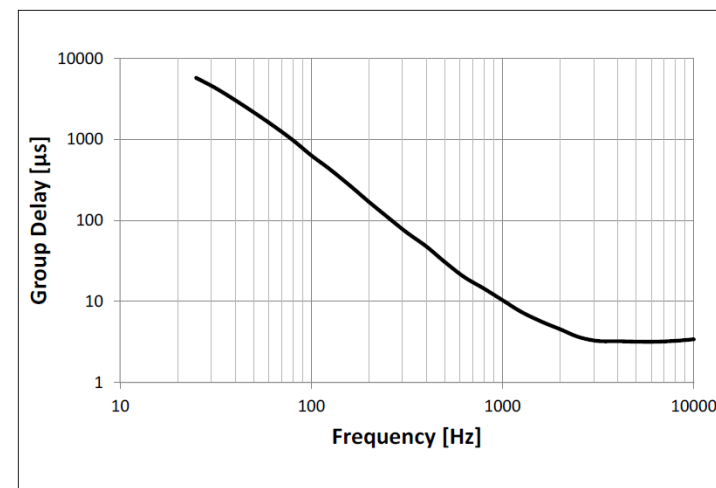


Figure 5 Typical group delay

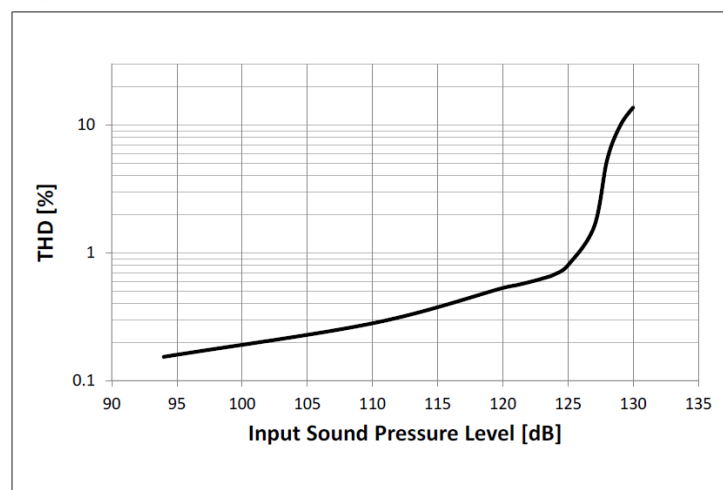


Figure 6 Typical THD vs SPL

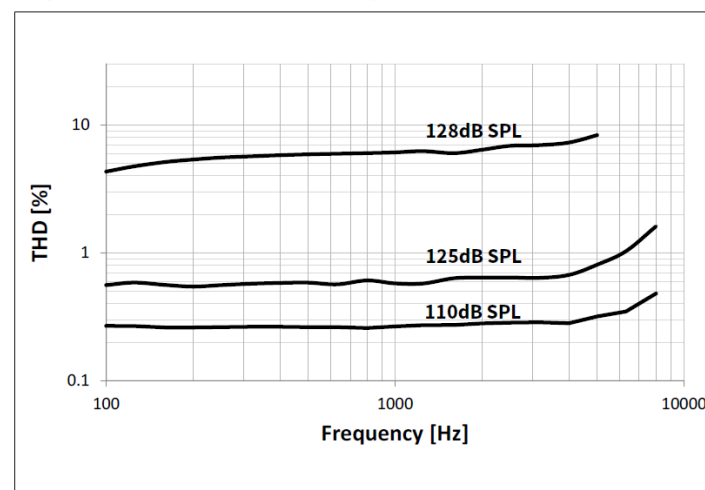


Figure 7 Typical THD vs frequency

2 典型性能特性

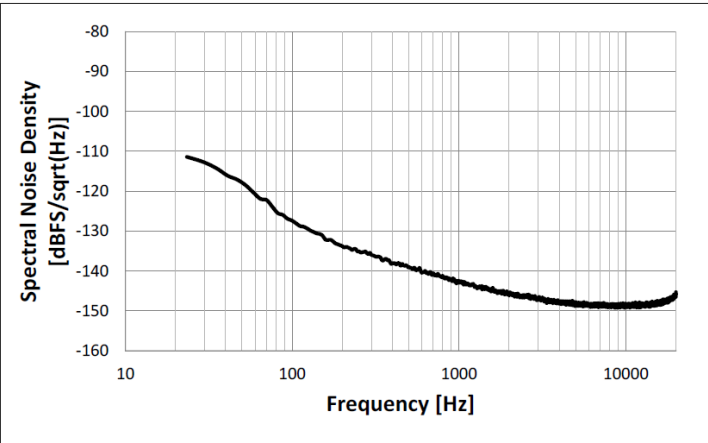


Figure 8 Typical noise floor (unweighted)

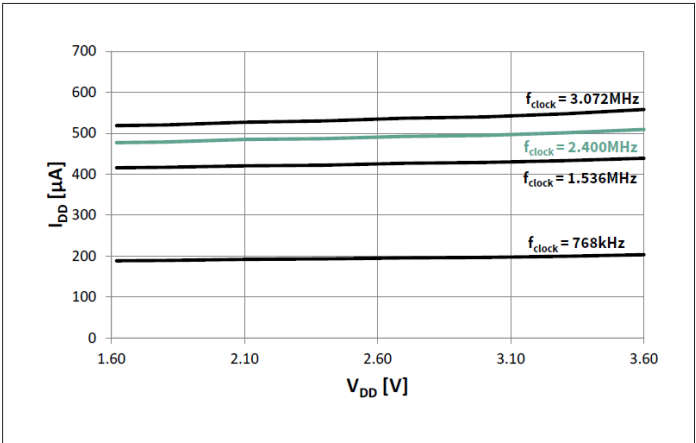


Figure 9 Typical I_{DD} vs V_{DD}

3. 声学特性

3 声学特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 1.8V$ 、 $f_{CLK} = 3.072MHz$ 、 $OSR=64$ 、 $T_A = 25^{\circ}C$ 、55% R.H.、音频带宽 20Hz 至 20kHz、Select引脚接地、DATA 上无负载、 $T_{edge} = 9ns$

Table 1 Acoustic specifications

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note or Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Sensitivity		S	-38	-37	-36	dBFS	1kHz, 94 dB SPL, all operating modes
Low Frequency Roll-off		LFRO		30		Hz	-3dB relative to 1kHz
Resonant Frequency Peak				30		kHz	
Signal to Noise Ratio	F _{clock} = 768kHz	SNR		66		dB(A)	20Hz to 8kHz bandwidth, OSR: 48, A-Weighted
	F _{clock} = 1.536MHz			67.5			20Hz to 12kHz bandwidth, A-Weighted
	F _{clock} = 2.4MHz			68			20Hz to 20kHz bandwidth, A-Weighted
	F _{clock} = 3.072MHz			69			
Total Harmonic Distortion	94dB SPL	THD			0.3	%	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ, all operating modes
	125dB SPL			1.0			
Acoustic Overload Point	10% THD	AOP		128		dB SPL	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ, all operating modes
Group Delay	250Hz			120		μs	
	600Hz			20			
	1kHz			10			
	4kHz			3.5			
Phase Response	75Hz			25		°	
	1kHz			1			
	4kHz			-4			
Directivity			Omnidirectional				
Polarity		Positive pressure increases density of 1's, negative pressure decreases density of 1's in data output					

4 电气特性及参数

4.1 绝对最大额定值

超过所列最大额定值运行器件可能会影响器件可靠性或导致器件永久性损坏。在这些条件下，无法保证器件正常运行。

Table 2 Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Values		Unit	Note / Test Condition
		Min.	Max.		
Voltage on any Pin	$V_{\max}$		3.6	V	
Storage Temperature	T_S	-40	125	°C	
Ambient Temperature	T_A	-40	85	°C	

4.2 电气参数

Table 3 Electrical parameters and digital interface input

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Supply Voltage		V_{DD}	1.62	1.8	3.6	V	¹⁾
Clock Frequency Range	Standby Mode	f_{clock}			350	kHz	²⁾
	Low Power Mode		380	768	1020	kHz	
	Normal Mode		1.2	3.072	3.3	MHz	
V_{DD} Ramp-up Time					50	ms	Time until $V_{DD} \geq V_{DD_min}$
Input Logic Low Level		V_{IL}			$0.3 \times V_{DD}$	V	
Input Logic High Level		V_{IH}	$0.7 \times V_{DD}$			V	
Clock Rise/Fall Time					13	ns	10% to 90%
Clock Duty Cycle			45		55	%	
Output Load Capacitance on DATA		C_{load}			100	pF	

¹⁾ 应将1μF 旁路电容放置在靠近麦克风 V_{DD} 焊盘的位置，以保证最优的 SNR 性能。

²⁾ 待机模式下Data焊盘为高阻抗。

4 电气特性及参数

4.3 电气特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 1.8V$, $T_A = 25^{\circ}C$, 55% R.H.

Table 4 General electrical characteristics

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Current Consumption	Clock Off Mode	$I_{\text{clock_off}}$			1	μA	CLOCK pulled low
	Standby Mode	I_{standby}		25	50		No load on DATA
	$F_{\text{clock}} = 768\text{kHz}$	I_{DD}		180	250		<5pF load on DATA
	$F_{\text{clock}} = 1.536\text{MHz}$			420			
	$F_{\text{clock}} = 2.4\text{MHz}$			480			
	$F_{\text{clock}} = 3.072\text{MHz}$			520	650		
Short Circuit Current			1		20	mA	Grounded DATA pin
Power Supply Rejection		PSR_{1k_NM}		-80		dBFS	100mV _{pp} sine wave on V_{DD} swept from 200Hz to 20kHz.
		PSR_{217_NM}		-86		dBFS(A)	100mV _{rms} , 217Hz square wave on V_{DD} . A-weighted.
Startup Time	$\pm 0.5\text{dB}$ sensitivity accuracy				20	ms	Time to start up in any operating modes after V_{DD_min} and CLOCK have been applied. ³⁾
	$\pm 0.2\text{dB}$ sensitivity accuracy				50		
Mode Switch Time	$\pm 0.5\text{dB}$ sensitivity accuracy				20	ms	Time to switch between operating modes. V_{DD} remains on during the mode switch. ³⁾
	$\pm 0.2\text{dB}$ sensitivity accuracy				50		
Output Logic Low Level		V_{OL}			$0.2 \times V_{DD}$	V	
Output Logic High Level		V_{OH}	$0.8 \times V_{DD}$				
Delay Time for DATA Driven		t_{DD}	40		80	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA driven.
Delay Time for DATA High-Z ⁴⁾		t_{HZ}	5		30	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA high impedance state
Delay Time for DATA Valid ⁵⁾		t_{DV}			100	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA valid ($<0.3 \times V_{DD}$ or $>0.7 \times V_{DD}$)
Power-on behaviour		Idle tone is output over PDM within 3ms of applying V_{DD} and f_{clock} , remains until a valid microphone signal is available. Idle tone consists of alternating 1s and 0s, representing a zero input signal.					

³⁾ 每种电源模式都是在典型的 PDM 时钟频率下验证的。

⁴⁾ t_{hold} 取决于 C_{load}

⁵⁾ Data 上的负载： $C_{\text{load}} = 100\text{pF}$, $R_{\text{load}} = 100\text{k}\Omega$

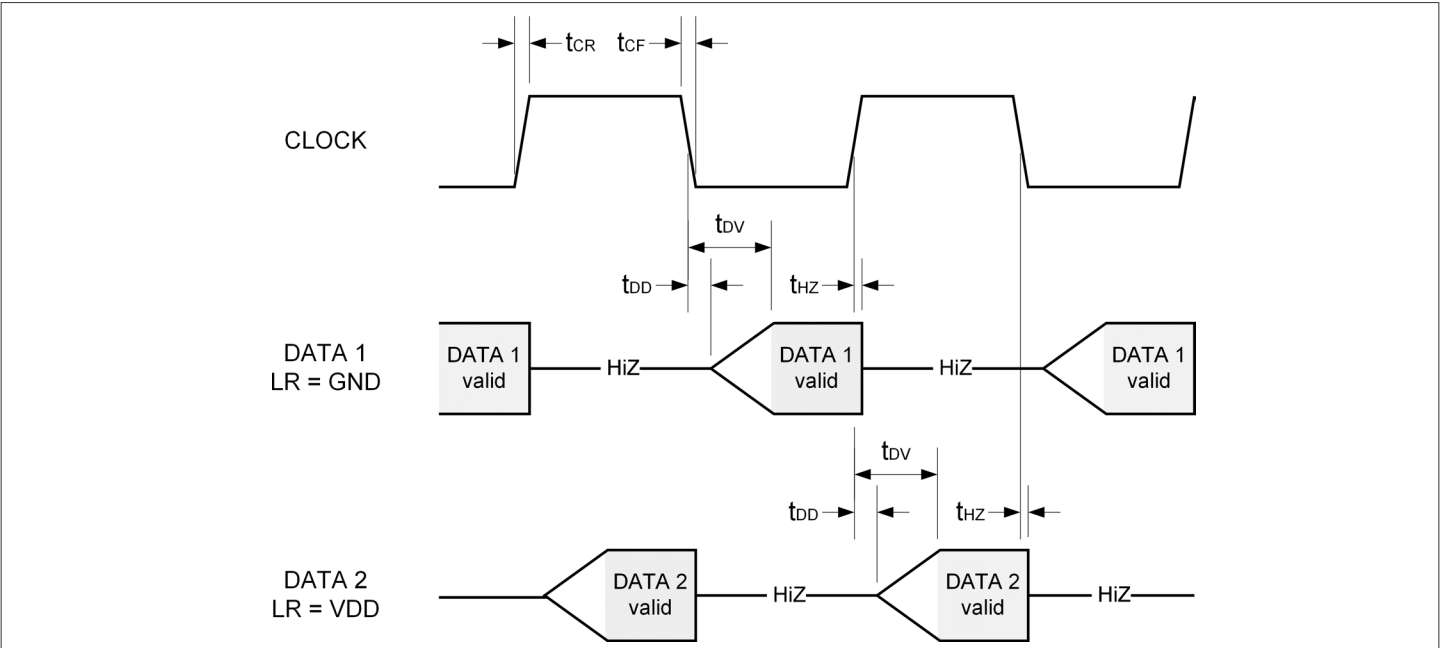


Figure 10 Timing diagram

4.4 音频DC偏置

数据流中的 DC 输出电平由启动时 L/R 的状态决定。在每种情况下 DC 输出电平随时间保持稳定，并不会随输入信号电平而变化。

Table 5 DC output level using L/R pin

LR state	DC output level (typical)	Unit
LR = GND	-80	dBFS
LR = VDD	-40	dBFS

4.5 立体声PDM配置

IM69D128S 可用在 PDM 总线上的一个或两个麦克风的电路中。当连接两个麦克风时，可根据每个麦克风的L/R引脚状态交替传输数据。当连接到同一 PDM 总线时，两个麦克风的电源模式是相同的，因为它们都由相同的 PDM 时钟控制。与每条总线单个麦克风的配置相比，立体声PDM配置下的性能是没有变化的。

Table 6 PDM channel configuration using L/R pin.

Channel	Data driven	Data high-Z	L/R connection
DATA1	Falling clock edge	Rising clock edge	GND
DATA2	Rising clock edge	Falling clock edge	V _{DD}

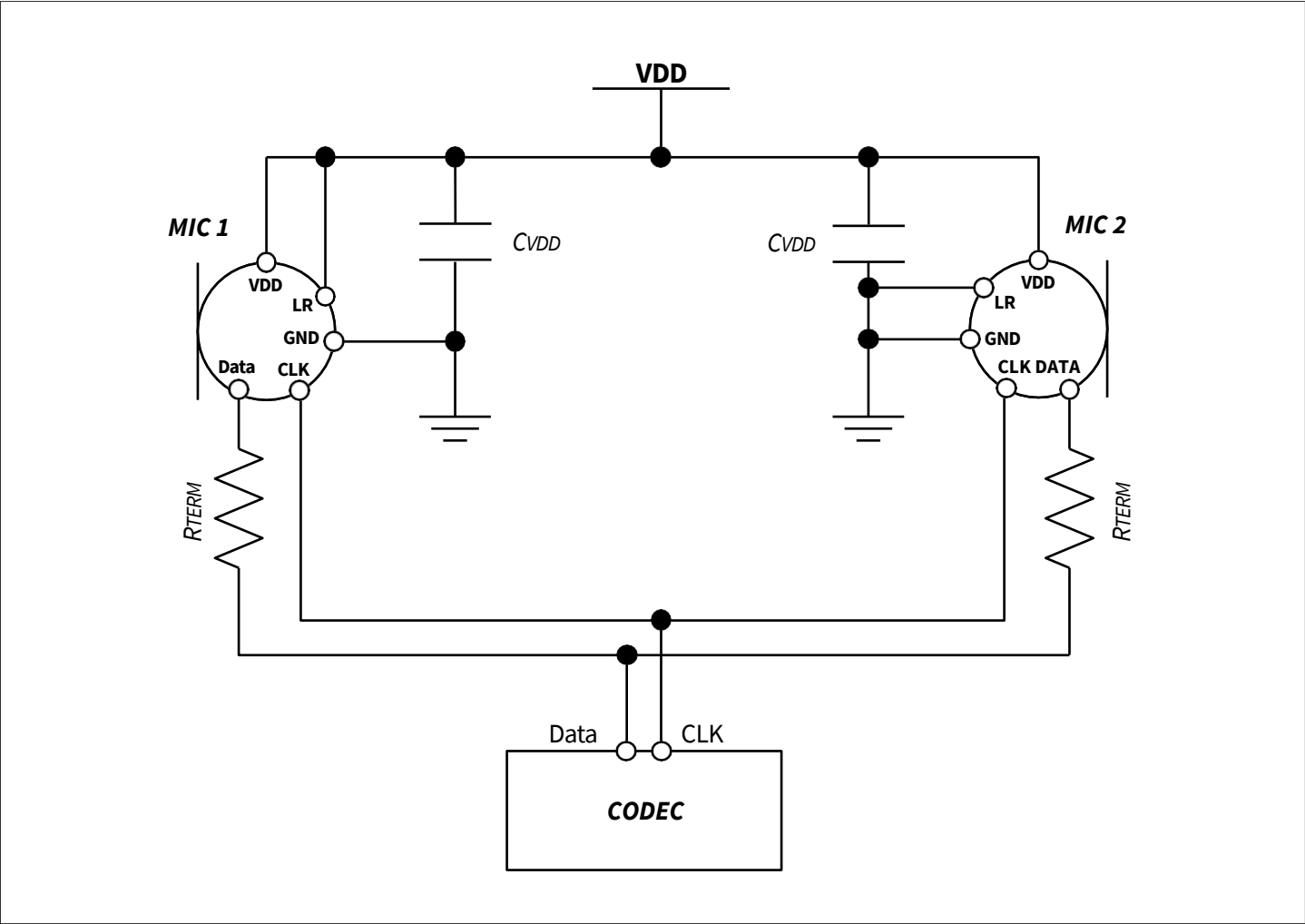


Figure 11 Typical stereo mode configuration

注：为获得最佳性能，强烈建议在VDD和地之间放置一个100nF (C_{VDD_typical}) 的电容。该电容应尽可能靠近V_{DD}。可以添加一个约100Ω的终端电阻(R_{TERM})，以减少输出信号上的振铃和过冲。

5 封装信息

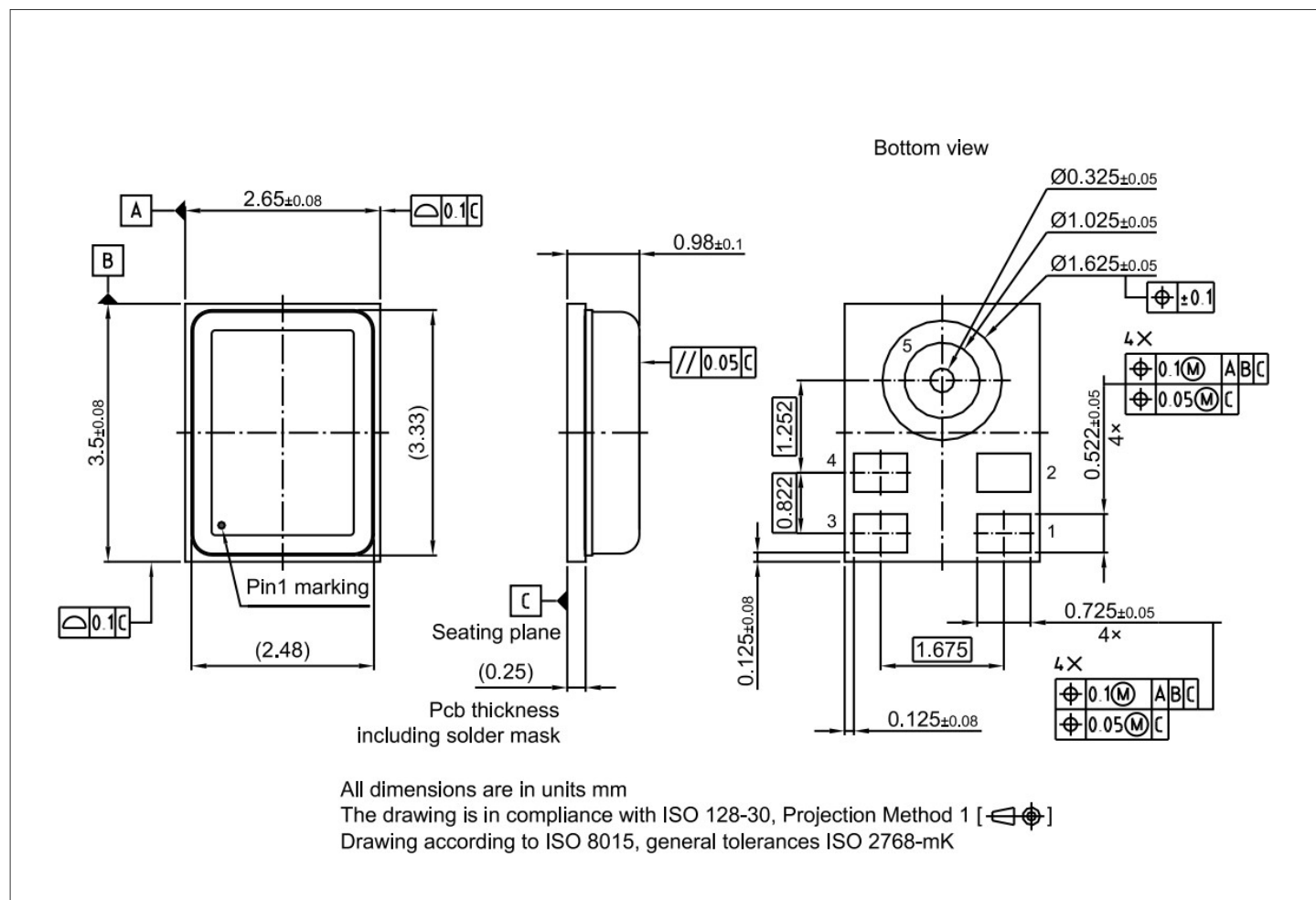


Figure 12 IM69D128SV01 package drawing

Table 7 IM69D128SV01 pin configuration

Pin Number	Name	Description
1	V _{DD}	Power supply
2	CLOCK	PDM clock input
3	DATA	PDM data output
4	LR select	PDM left/right select
5	GND	Ground

6. 焊盘和钢网模板推荐

6 焊盘和钢网模板推荐

为保证最优性能，PCB 上的声孔直径应大于 MEMS 麦克风的声孔直径。建议的 PCB 声孔直径为 0.6 毫米。

如图13所示的电路板焊盘和钢网模板孔径建议基于阻焊定义 (SMD) 焊盘。应考虑电路板制造商的具体设计规则，以进行个别设计的优化或调整。

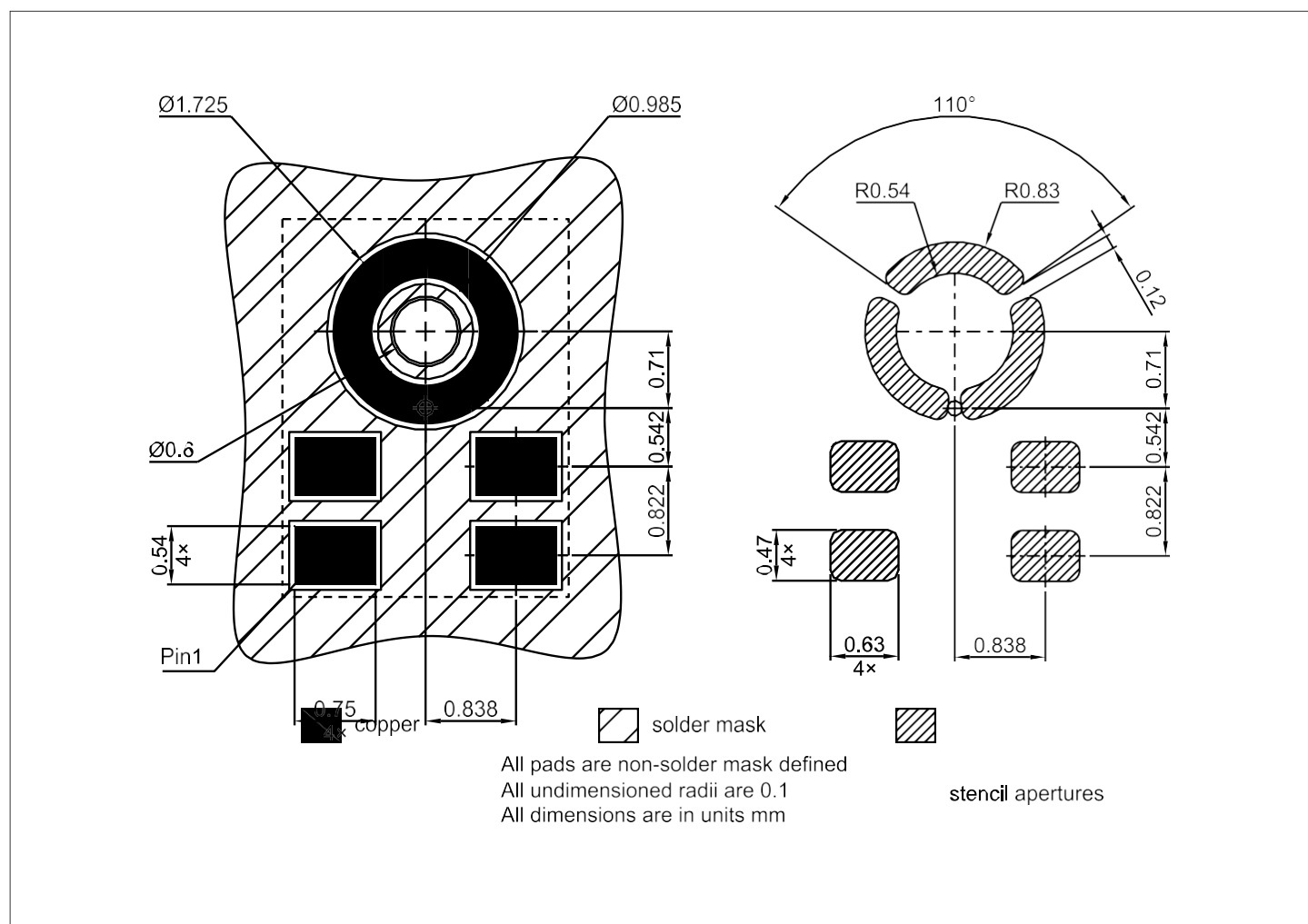


Figure 13 Footprint and stencil recommendation

7 包装信息

为了便于运输和组装，英飞凌麦克风采用专用的卷带式载带进行包装。载带的详细图纸如图 14 所示

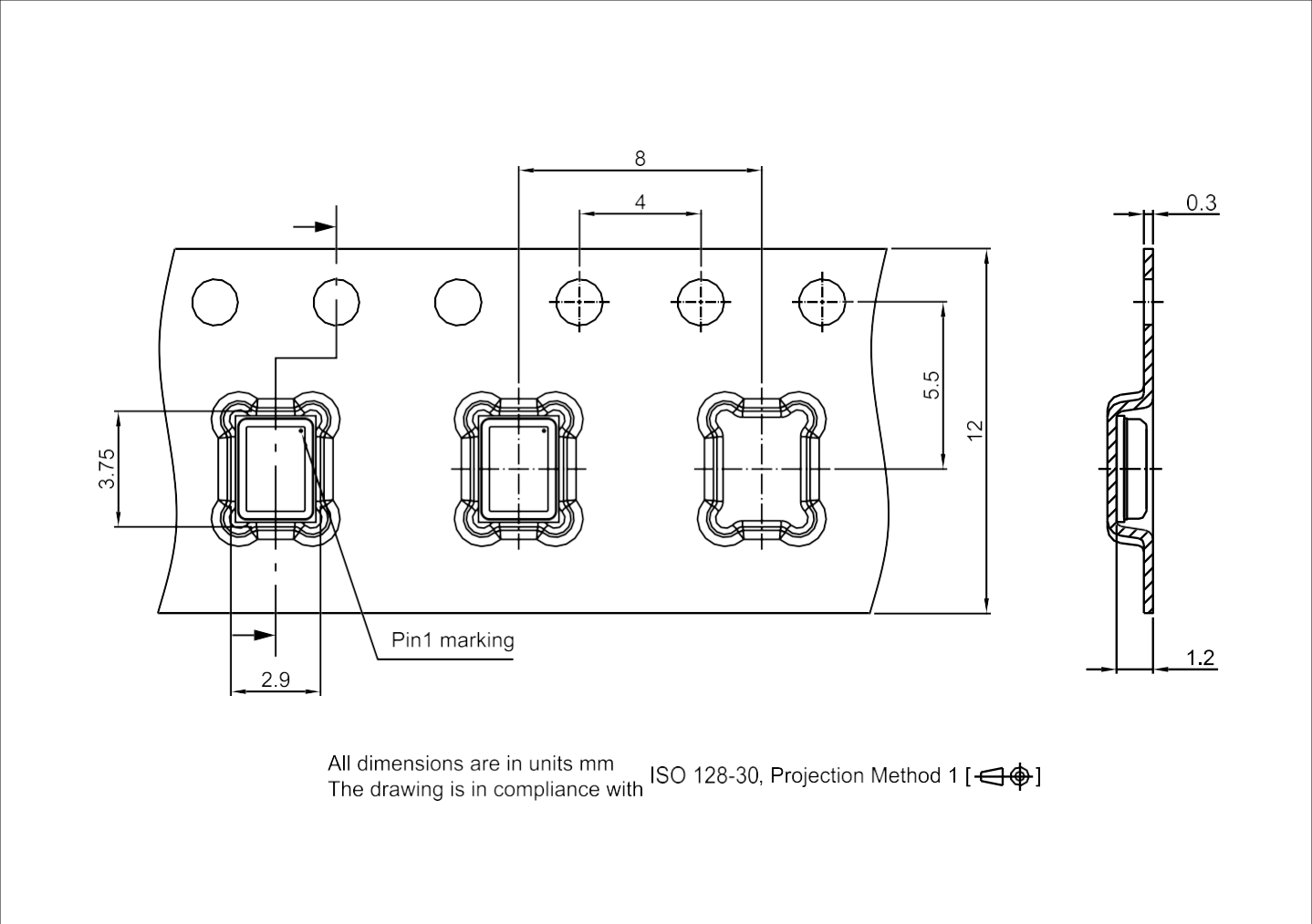


Figure 14 IM69D128SV01 tape and reel packing information

Table 8 IM69D128SV01 packaging information

Product	Type code	Reel diameter	Quantity per reel
IM69D128SV01	l69D18	13"	5000

8 回流焊和电路板组装

英飞凌 MEMS 麦克风符合 IPC/JEDEC J-STD-020D-01 标准。MEMS麦克风的湿气敏感性等级为MSL1。建议使用回流焊来进行MEMS麦克风的PCB组装。

为达到最优的焊接质量，回流温度曲线应与锡膏制造商的建议一致。推荐用图15所示的回流温度曲线 来生产包含英飞凌 MEMS 麦克风的电路板。

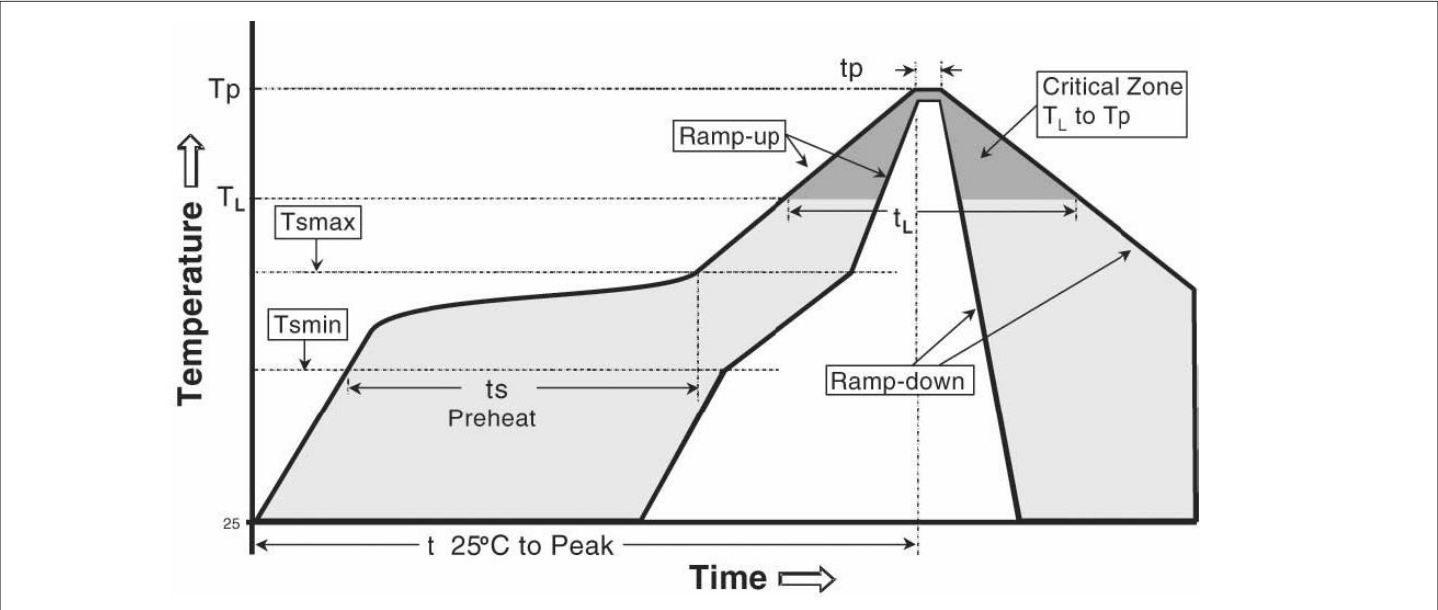


Figure 15 Recommended reflow profile

Table 9 Reflow profile limits

Profile feature	Pb-Free assembly	Sn-Pb Eutectic assembly
Temperature Min (T_{smin})	150 °C	100 °C
Temperature Max (T_{smax})	200 °C	150 °C
Time (T_{smin} to T_{smax}) (t_s)	60-120 seconds	60-120 seconds
Ramp-up rate (T_L to T_p)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T_L)	217 °C	183 °C
Time (t_L) maintained above T_L	60-150 seconds	60-150 seconds
Peak Temperature (T_p)	260°C +0°C/-5°C	235°C +0°C/-5°C
Time within 5°C of actual peak temperature (t_p) ⁶⁾	20-40 seconds	10-30 seconds
Ramp-down rate	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.	6 minutes max.

注： 更多信息请参阅英飞凌科技网页上的“英飞凌封装组装的一般建议”文档

⁶⁾ 峰值温度 (T_p) 的公差定义为供应商的最小值和用户的最大值

MEMS 麦克风可以使用行业标准的取放设备。应注意避免损坏麦克风结构，如下所示：

- 请勿使用接触麦克风声孔的真空工具拾取麦克风。
- 麦克风声孔不应暴露在真空中，否则会破坏 MEMS。
- 请勿将空气吹入麦克风声孔。如果采用吹气清洁工艺，则必须将声孔密封以防止颗粒物污染。
- 推荐在无尘室环境中进行 PCB 组装，以避免麦克风受到污染。
- 不应将吹气和超声波清洁工艺应用于 MEMS 麦克风。建议在组装时使用免清洗锡膏，以避免后续的清洁步骤。清洁物质可能会严重损坏麦克风的 MEMS。
- 为防止PCB组装时声孔被堵塞或部分堵塞，建议在PCB切割或系统组装时用保护胶带覆盖声孔。
- 将麦克风放置在 PCB 上时请勿用力过猛。建议使用行业标准的拾取和放置工具，以限制施加在封装上的机械力。

9 可靠性规格

测试后的麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过 3dB。

Table 10 Reliability specification

Test	Abbreviation	Test Condition	Standard
Low Temperature Operating Life	LTOL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
Low Temperature Storage Life	LTSL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A119
High Temperature Operation Life	HTOL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
High Temperature Storage Life	HTSL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A103
Temperature Cycling	PC + TC	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		1000 cycles, -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$, 30 minutes per cycle	JESD22-A104
Temperature Humidity Bias	PC + THB	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		$T_a = +85^{\circ}\text{C}$, R.H = 85%, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A101
Vibration Test	VF	20Hz to 2000Hz with a peak acceleration of 20g in X, Y, and Z for 4 minutes each, total 4 - cycles	IEC 60068-2-6
Mechanical Shock	MS	10000g/0.1msec direction $\pm x, y, z$, 5 shocks in each direction, 5 shocks in total	IEC 60068-2-27
Reflow Solder ⁷⁾	RS	3 reflow cycles, peak temperature = $+260^{\circ}\text{C}$	IPC-JEDEC J-STD-020D-01
Electrostatic Discharge -System Level Test	ESD - SLT	3 discharges of $\pm 8\text{kV}$ direct contact to lid while V_{dd} is supplied according to the operational modes; (V_{dd} ground is separated from earth ground)	IEC-61000-4-2
Electrostatic Discharge - Human Body Model	ESD - HBM	1 pulse of $\pm 2\text{kV}$ between all I/O pin combinations	JEDEC-JS001
Electrostatic Discharge - Charged Device Model	ESD - CDM	3 discharges of $\pm 500\text{V}$ direct contact to I/O pins.	JEDEC JS-002

⁷⁾ 经过3轮回流后，麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过1dB。

9.1 环境稳健性

英飞凌最新的密封双膜 MEMS 技术实现了麦克风级别的高等级防护 (IP57)。密封的 MEMS 设计可防止水或灰尘进入膜片和背板之间，从而防止 MEMS 麦克风中常见的机械阻塞或电流泄漏问题。采用密封双膜技术制造的麦克风仅需要简单的防护即可用于 IP68 的产品中。

Table 11 Environmental robustness

Test Standard	Test Condition
IP5x dust resistance ⁸⁾	Arizona dust A4 coarse, vertical orientation, sound hole upwards, 10 cycles (15 minutes sedimentation, 6 sec blowing)
IPx7 water immersion ⁹⁾	Temporary immersion of 1 meters for 30 minutes. Microphone tested 2 hours after removal

⁸⁾ 数字“5”代表防尘等级或抵抗细小磨蚀性灰尘颗粒影响的能力。

⁹⁾ “7”代表更高的防水等级。



修订记录

修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
v1.00	2023-01-05	Initial datasheet release
v1.01	2023-01-18	Corrected package information



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-24

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG.

All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?

Email:

erratum@infineon.com

重要提示

本文件所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文件中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文件所提供的任何信息均取决于客户履行本文件所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文件所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文件中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。